

2SA766

シリコン PNP 二重拡散メサ型/Si PNP Double Diffused Mesa

電源直結式垂直偏向出力用/Line-Operated Vertical Deflection
Output

中電力増幅用/Medium Power Amplifier

2SC1450 とコンプリメンタリ/Complementary pair with 2SC1450

特 徴/Features

- 許容コレクタ損失 P_C が大きい。/Large collector dissipation
- 2SC1450 とコンプリメンタリペアで OTL 垂直偏向出力回路の構成が可能です。/

Suited for OTL complementary vertical deflection output circuit.

最大定格/Absolute Maximum Ratings ($T_a=25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	$-V_{CBO}$	150	V
コレクタ・エミッタ電圧 ($R_{BE} \leq 5k\Omega$)	$-V_{CER}$	150	V
エミッタ・ベース電圧	$-V_{EBO}$	5	V
せん頭コレクタ電流	$-I_{CM}$	1.2	A
コレクタ電流	$-I_C$	0.4	A
コレクタ損失 ($T_c \leq 80^\circ\text{C}$)	P_C	20	W
接合部温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	$-65 \sim +150$	$^\circ\text{C}$

電気的特性/Electrical Characteristics ($T_a=25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタ・エミッタ電圧	$-V_{CER(sus)}$	$-I_C=0.2A, L=25mH, R_{BE}=5k\Omega$	150			V
エミッタ・ベース電圧	$-V_{EBO}$	$-I_E=1mA, I_C=0$	5			V
コレクタシャ断電流	$-I_{CBO}$	$-V_{CB}=60V, I_E=0$			30	μA
直流電流増幅率	h_{FE1}	$-V_{CE}=5V, -I_C=0.1A^{**}$	35		150	
	h_{FE2}	$-V_{CE}=5V, -I_C=0.5A^{**}$	35			
ベース・エミッタ電圧	$-V_{BE1}$	$-V_{CE}=5V, -I_C=0.1A^{**}$	0.5		0.8	V
	$-V_{BE2}$	$-V_{CE}=5V, -I_C=0.5A^{**}$			1.0	V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$-V_{CE(sat)}$	$-I_C=1A, -I_B=0.1A^{**}$			1.0	V
トランジション周波数	f_T	$-V_{CB}=10V, I_E=0.1A$		15		MHz

** パルス測定/Pulse Test

